

# Transistors à 45 nanomètres : Toshiba coiffe Intel

Alors qu'Intel semble réserver la technique du 'silicium tendu' (

*strained silicium*) à sa future génération de processeurs à 90 nanos, Toshiba est le premier à exploiter la technologie pour la fabrication de transistors à 45 nanos. Le '*Nikkei Business Daily*' indique que les bornes 'plus' et 'moins' des transistors CMOS utilisent des électrodes réunies par un pontage sous technique du silicium 'tendu', ce qui leur permet de commuter plus de dispositifs qu'en technologie non tendue, pour un gain de vitesse d'environ 10%...